

埼玉大学大学院理工学研究科

博士前期課程 物理機能系専攻 物理学コース

平成 25 年度（第 2 次募集）入学試験問題

物 理 学

2013 年 2 月 19 日 13:00 ～ 15:00

注 意 事 項

1. 試験開始の合図があるまで、この冊子を開いてはいけない。
2. 試験開始 60 分以内の退室は認めない。
3. この問題冊子と答案用紙 4 枚が配布される。すべての答案用紙の所定の欄に受験番号を記入すること。
4. 問題は 1 から 4 まで 4 問ある。それぞれ別の答案用紙に解答すること。解答に際して、問題が小問に分かれている場合には、小問の番号や記号を明瞭に記すこと。裏面まで解答が及ぶ場合には、「裏に続く」と下に書くこと。
5. 問題冊子および答案用紙に、枚数の不足や印刷に不鮮明なところがある場合には、手を挙げて申し出ること。
6. 終了後は、解答の有無にかかわらず、答案用紙 4 枚の全てを提出すること。
7. 問題冊子は持ち帰ること。

1

(75 点)

以下の3問に答えよ。

(問 1)ばね定数 k 、自然長 L のばねの下端に質量 m の大きさの無視できるおもりをつり下げる。ばねの上端を角振動数 ω 、振幅 h で強制的に上下に動かした。ばねとおもりの振動方向を x 軸とし、時刻 $t=0$ において、ばねの上端の位置を原点 $x=0$ とする。時刻 $t=0$ で、ばねとおもりは静止しており、時刻 t における上端の位置を $x_0(t)$ 、おもりの位置を $x(t)$ とする。重力加速度の大きさを g とし、以下の間に答えよ。

- (a) 上端の位置 $x_0(t)$ を h, ω, t をもちいて表せ。
- (b) おもりの運動方程式を求めよ。
- (c) 運動方程式を解いて、おもりの運動について説明せよ。

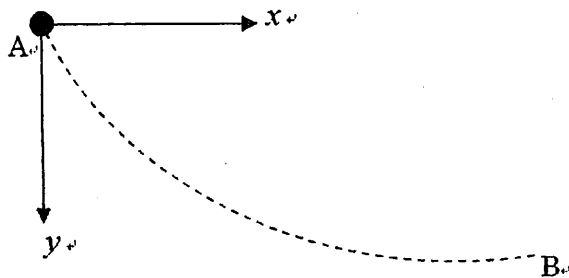
(問 2) 2次元平面上の点 (x, y) にある質量 m の物体が、図に示すように y 軸を鉛直下向き方向にとり、点 $A(0, 0)$ からある経路 (点線で示すような) に沿って、初速 0 で運動をはじめ、鉛直下向きの重力のみの作用のもとで点 $B(x_1, y_1)$ に到着する。経路の微小長さ ds を通過する時間を $dt = \frac{ds}{v}$ とするとき (v は経路に沿った物体の速さ)、所要時間は $T = \int_A^B \frac{ds}{v}$ となる。重力加速度の大きさを g とし、以下の間に答えよ。

- (a) ds と v を x, y を用いた式で置き換えて、所要時間を表す式、

$$T = \int_0^{y_1} P\left(y, \frac{dx}{dy}\right) dy \text{ における, 関数 } P\left(y, \frac{dx}{dy}\right) \text{ を求めよ。}$$

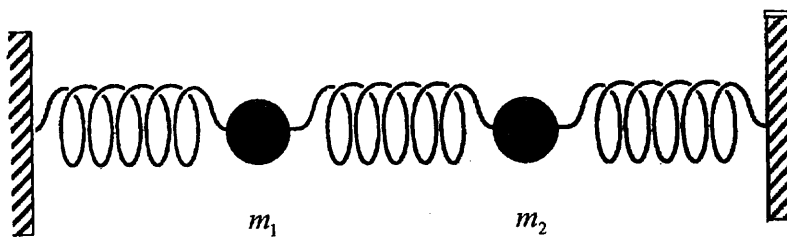
- (b) T を最小にするための条件を与える Euler の微分方程式を求めよ。

- (c) AB 間の経路の中で、点 B に到着するまでの所要時間が最小になる経路を求めよ。
- (d) 直線 AB が最短の距離経路であるにもかかわらず、所要時間が最小にならない理由をわかりやすく説明せよ。



(問 3) 下図に示したように、重力が働かない真空中で、壁に固定された 2 振子 (質量 m_1, m_2) による連成ばねを考える。ただし 3 つのばねについて、ばね定数はすべて同じ k とし、ばねは壁がある方向に 1 次元的にしか動かないものとする。

- (a) 座標軸を適当に取り、この系のラグランジアンを求めよ。
- (b) Euler-Lagrange 方程式をつくり、解を求めよ。



2

(75点)

無限に広がったある平面上に電荷が一様に分布している。電荷面密度は σ である。この平面を xy 面として、このまわりの電場を、以下の3つの方法で求めよ。真空の誘電率は ϵ_0 とせよ。

- (問 1) ① この系が平面に垂直にとった軸(z 軸)のまわりの回転に対して対称であることから、この平面上で半径が r と $r+dr$ の円環を考える。この円環上に分布した電荷が、円環の中心から垂直な直線上の点につくる電場を求めよ。
- ② ①の結果を積分することで、平面全体に分布する電荷による電場を求めよ。平面の上下の電場の大きさと方向について示すこと。

(問 2) ガウスの法則を使って、この電場を求めよ。

(問 3) ① 電位 ϕ と電荷密度 ρ が満足する関係式(三次元のポアソン方程式)を導け。

② 上で示した関係式を、この平面上の一様電荷の問題に適用して電場を求めよ。

次に真空中で、それぞれ $\pm\sigma$ の面密度の電荷を持った2枚の平行板(面積 S)を距離 d だけ離して絶縁し、平行板コンデンサーとする。ここで板の端における影響は無視する。

(問 4) ① 極板内外の電場(E)と電束密度(D)を求めよ。それぞれの大きさと方向を示すこと。

② このコンデンサーに同じ面積 S の誘電体の板(厚さ t , 誘電率 ϵ)を極板に平行に、板の端を一致させて差し入れた。このときの極板内外の電場(E)と電束密度(D)を求めよ。それぞれの大きさと方向を示すこと。

3 (75点)

質量 m の量子力学的粒子が

$$V(x) = \begin{cases} \infty & (|x| \geq \frac{a}{2}) \\ 0 & (|x| < \frac{a}{2}) \end{cases}$$

で与えられる一次元ポテンシャル $V(x)$ の中を定常運動する場合を考えよう (a は正の定数)。以下の解答では、 $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ (h はプランク定数) を用いて良い。また、解答にあたって必要な記号は定義をして適宜用いよ。

- (問1) 波動関数を $\phi(x)$ で表すとき、この系のシュレディンガー方程式を記せ。
- (問2) 固有エネルギー E_n ($n=1,2,\dots$) と規格化された波動関数 $\phi_n(x)$ を具体的に求めよ。
- (問3) 摂動ポテンシャル $U(x) = A \cos\left(\frac{\pi x}{2a}\right)$ (A は定数) が加わった時、1 次の摂動による固有エネルギーの変化 $E_n^{(1)}$ を求めよ。

今状態が $\phi(x) = B \left[\left(\frac{a}{2}\right)^2 - x^2 \right]$ (B は正の定数) で与えられたとする。

- (問4) 規格化定数 B を a で表せ。また、(問2) で与えられる状態 $\phi_n(x)$ にいる確率 P_n を求めよ。

4 (75点)

一辺の長さ L の 3次元の箱 (体積 $L^3 \equiv V$) に閉じ込められている $2N$ 個の自由電子に対して、絶対零度での振る舞いを考える。 \hbar ($\equiv \frac{h}{2\pi}$, h はプランク定数), 電子の質量 m , ボーア磁子 μ_B として以下の問に解答せよ。

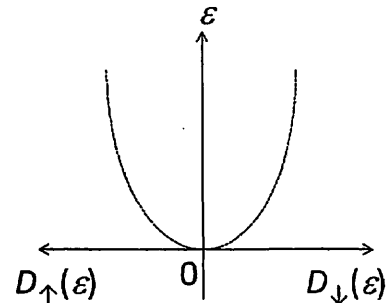
(問1) フェルミ波数 k_F , ならびにフェルミエネルギー E_F を求めよ。

(問2) 電子のエネルギーを ε としたとき, 各スピンあたりの状態数 $\Omega_{\uparrow}(\varepsilon)$ ($= \Omega_{\downarrow}(\varepsilon)$) を求めよ。次にその微分 $d\Omega_{\uparrow}/d\varepsilon$ ($= d\Omega_{\downarrow}/d\varepsilon$) を計算することにより, 状態密度が以下で与えられることを示せ。ただし, \uparrow, \downarrow はそれぞれ, 上向きスピン, 下向きスピンを表すものとする。

$$D_{\uparrow}(\varepsilon) = D_{\downarrow}(\varepsilon) = \frac{V}{\sqrt{2\pi^2\hbar^3}} m^{\frac{3}{2}} \varepsilon^{\frac{1}{2}}$$

次に, 磁場中での振る舞いを考える。一様な磁場 H 中に置かれている電子は磁場の方向に平行に $\mu_B H$ (反平行に $-\mu_B H$) のエネルギーをもつ。

(問3) 右図はゼロ磁場下での電子の状態密度について, 縦軸エネルギー ε , 横軸左側 (右側) を \uparrow スピン (\downarrow スピン) の状態密度として描いたものであるが, 磁場下で状態密度はどのように変更されるか解答用紙に図示せよ。なお, 磁場下での電子のとりうる最大エネルギーを ε_0 とせよ。



(問4) \uparrow スピン, \downarrow スピンをもつ電子のとりうる最大の波数 $k_{F\uparrow}$, $k_{F\downarrow}$ を求めよ。

(問5) \uparrow スピン, \downarrow スピンをもつ電子数 N_{\uparrow} , N_{\downarrow} を求め, 次に全磁気モーメントを求めよ。

(問6) $\varepsilon_0 \gg \mu_B H$ として磁化を H の一次まで展開し, 帯磁率を求めよ。